

## 有色金属-国际-SEMI 半导体-硅材料工艺控制标准

录入：杨和平 www.radtek.cn 2014-11-9

序号	标准号	标准名称	所属委员会/卷号
1	SEMI MS1-0306	晶片结合对准标线规范指南	
2	SEMI MF 2166-0304	通过使用特殊参考晶片监控非接触式电 介质评定系统的方法	
3	SEMI MF 2139-1103	采用二次离子质谱法测量硅衬底上氮浓 度的方法	
4	SEMI MF 2074-1103	硅及其他半导体材料晶片直径的测量方 法指南	
5	SEMI MF 1982-1103	热解吸附气相色谱法评估硅片表面有机 污染物的方法	
6	SEMI MF1811-0704	从表面轮廓数据估计功谱密度和相关加 工参数的指南	
7	SEMI MF 1810-0304	用于记录硅片择优腐蚀和加工表面缺陷 的方法	
8	SEMI MF 1809-0704	表征硅中结构缺陷的腐蚀溶液的选择和 使用指南	
9	SEMI MF 1771-0304	通过电压斜线上升技术评估栅极氧完整 性的方法	
10	SEMI MF 1763-0706	线性偏光镜测试方法	
11	SEMI MF 1727-0304	硅抛光片表面氧化诱生缺陷的检测方法	
12	SEMI MF 1726-1103	硅片结晶学完整性分析规程	
13	SEMI MF 1725-1103	硅锭结晶学完整性的分析方法	
14	SEMI MF 1724-1104	采用酸萃取-原子吸收光谱法测量多晶 硅表面金属沾污	
15	SEMI MF 1723-1104	通过漂移区生长和光谱法评价多晶硅棒 的方法	
16	SEMI MF 1708-1104	用区融和光谱分析仪评定粒状多晶硅的 规程	

17	SEMI MF 1630-0704	单晶硅III-V级杂质的低温 FT-IR 分析测试方法	
18	SEMI MF 1619-1105	以布鲁斯特角入射 P 偏振辐射红外吸收光谱法测量硅片中间隙氧含量	
19	SEMI MF 1618-1104	硅晶片薄膜的不均匀性判定规程	
20	SEMI MF 1617-0304	二次离子质谱法测定硅和硅外延衬底表面上钠、铝和钾	

序号	标准号	标准名称	所属委员会/卷号
21	SEMI MF 1569-0705	半导体技术用统一参考材料的形成指南	
22	SEMI MF 1535-1106	用微波反射非接触光电导衰减方法测试硅晶片载流子复合寿命的方法	
23	SEMI MF 1530-1105	用非接触自动扫描法测量硅片平整度、厚度和厚度变化的试验方法	
24	SEMI MF 1529-1104	用双配置程序的一列式四点探针法评定薄板阻抗不均匀性的方法	
25	SEMI MF 1528-1104	用二次离子质谱法测量重掺杂 N 型硅衬底中的硼污染的方法	
26	SEMI MF 1527-1104	用于硅电阻测量仪器校准和控制的参考材料和参考晶片的使用指南	
27	SEMI MF 1451-1104	用自动无接触扫描法测量硅片峰谷差的方法	
28	SEMI MF 1392-1103	用带汞探针的容量-电压测量器测定硅晶片中净载流子密度分布的测试方法	
29	SEMI MF 1391-0704	红外吸收法测试硅中替位碳原子含量	
30	SEMI MF 1390-1104	自动非接触式扫描法测量硅晶片翘曲度的测试方法	
31	SEMI MF 1389-0704	III-V 号混合物中对单晶硅的光致发光分析的测试方法	

32	SEMI MF 1388-1106	用金属一氧化物-硅电容器容量-时间(C-T)法测定硅材料产生寿命 和生产速度的试验方法	
33	SEMI MF 1366-0305	用二次离子质谱法测量重掺杂硅衬底中氧含量的方法	
34	SEMI MF 1239-0305	用测量间隙氧减少方法测试硅晶片的氧析出特性	
35	SEMI MF 1188-1105	用短基线红外吸收法测试硅中间隙原子氧含量	
36	SEMI MF 1153-1106	用电容-电压测量法对硅金属氧化物结构特性的试验方法	
37	SEMI MF 1152-0305	硅片刻槽尺寸的测试方法	
38	SEMI MF 1049-0304	硅晶片上浅腐蚀坑检测的测试方法	
39	SEMI MF1048-1105	测量全反射集成分散器的方法	
40	SEMI MF 978-1106	采用瞬时电容法标示深能级半导体实验方法	

序号	标准号	标准名称	所属委员会/卷号
41	SEMI MF 951-0305	测量硅片间隙氧径向变化的试验方法	
42	SEMI MF 950-1106	用角抛光和疵点侵蚀加工法测量机械加工硅片表面晶体损坏深度的试验方法	
43	SEMI MF 928-0305	圆形半导体晶片及硬性磁盘基片的边缘轮廓的试验方法	
44	SEMI MF 847-0705	用 X 射线技术测量硅单晶片上的参考面结晶取向的方法	
45	SEMI MF 728-1106	尺寸测量用光学显微镜预置规范	
46	SEMI MF 723-1105	掺硼、掺磷和掺砷硅片的电阻率与掺杂剂浓度的换算惯例	

47	SEMI MF 674-0705	扩展电阻测量用硅的制备	
48	SEMI MF 673-1105	用非接触式涡流标尺测量半导体晶片电阻率或半导体薄膜薄层电阻的方法	
49	SEMI MF 672-0706	用扩展电阻探针测量硅晶片垂直于纵断面表面的电阻率的方法	
50	SEMI MF 671-0705	硅晶片及其他电子材料的参考面长度测量方法	
51	SEMI MF 657-0705	用非接触扫描法测量硅片的翘曲度及总厚度变化的试验方法	
52	SEMI MF 576-0706	用椭圆对称法测量硅衬底上绝缘体厚度及折射指数的试验方法	
53	SEMI MF 534-9796	硅片的弯曲度测试方法	
54	SEMI MF 533-0706	硅片厚度及厚度变化的测试方法	
55	SEMI MF 525-0705	用扩展电阻探针测量硅片电阻率的方法	
56	SEMI MF 523-0706	硅抛光片的目检规程	
57	SEMI MF 397-1106	用二探针法测定硅棒电阻率的标准方法	
58	SEMI MF 391-1106	通过测量稳态硅表面光致电压确定硅中少数载流子扩散长度的试验方法	
59	SEMI M F 374-1105	用直排四探针法测试硅外延层、扩散层、多晶硅和离子注入层的薄层电阻的试验方法	
60	SEMI MF 154-1105	鉴别镜面状硅片表面观察到的结构和沾污的指南	

序号	标准号	标准名称	所属委员会/卷号
61	SEMI MF 110-1105	用磨角和染色技术测定硅外延层或扩散层厚度的试验方法	

62	SEMI MF 95-1105	用红外线反射法测定重掺杂硅衬底上轻掺杂硅外延层厚度的试验方法	
63	SEMI MF 84-1105	用直排四探针法测量硅片电阻率的试验方法	
64	SEMI MF 81-1105	硅片径向电阻率变化测量方法	
65	SEMI MF 43-0705	半导体材料电阻率试验方法	
66	SEMI MF 42-1105	掺杂半导体材料导电类型试验方法	
67	SEMI MF 28-1106	光电导衰减测量法测定大块锗和硅中少数载流子寿命的方法	
68	SEMI MF 26-0305	测定半导体单晶体取向的方法	
69	SEMI ME1392-3005	在表面反射或散射的角分辨光散射测量指南	